

POLYCRYSTALLINE SILICON WAFER 多晶硅片

- ◆ 进口优质硅原料
- ◆ 全套日本先进设备
- ◆ 严格的质量控制体系
- ◆ 全方位保证硅片质量

PHYSICAL CHARACTERISTICS 物理特性

Parameter	参数	Specification	规格
Crystal growth method	生长方式	DSS	
Conductivity type / Dopant	型号/掺杂剂	P/Boron	
Oxygen concentration	氧含量	$\leq 1.0 \times 10^{18}$ atoms/cm ³	
Carbon concentration	碳含量	$\leq 5.0 \times 10^{17}$ atoms/cm ³	
Resistivity	电阻率	0.8-3.0 ohm-cm	
Lifetime	少子寿命	$\geq 2.0\mu\text{s}$	测量未钝化晶锭样块少子寿命, 等于或大于碘钝化后的10 μs

STRUCTURAL CHARACTERISTICS 结构特性

Appearance	外形	Square	直方
Thickness (T)	中心厚度	200 \pm 20 μm	
		190 μm \leq 中心厚度 \leq 220 μm	
TTV		$\leq 30\mu\text{m}$	
Dimension (W \times W)	边长	156 \pm 0.5mm	
Chamfer angle	倒角角度	45° \pm 10°	
Scratch depth	线痕	Depth < 15 μm , Not hard points	深度 < 15 μm , 没有硬点
Micro-Crystalline	微晶	Not allowed	不允许
Surface quality	表面质量	Clean surface, no oil contamination	表面清洁, 没有油污
Edge chip	边缘崩边	Not allowed	不允许
Warpage	翘曲度	< 75 μm	

JUST SOLAR CO., LIMITED

Tel: +86 21 53550075 Fax: +86 21 63803857

Email: sales@jusolar.com

Website: www.jusolar.com

www.just-solar.net